150 kHz 生长型复合 Nd:YVO₄/Nd:GdVO₄ 电光调 Q 激光器

刘 瑞 于永吉 陈薪羽 王 超 吴春婷 金光勇

(长春理工大学理学院, 吉林省固体激光技术与应用重点实验室, 吉林 长春 130022)

摘要 报道了一种激光二极管(LD)端面抽运生长型复合晶体的 RTP 电光调 Q 激光器,实现了最高重复频率 150 kHz的 TEM₀₀模激光输出,并且对比了生长型复合 Nd:YVO4和 Nd:GdVO4晶体在高重复频率电光调 Q 激光 器中的表现。实验表明在中小抽运功率下,具有更大发射截面和适中上能级寿命的复合 Nd:YVO4晶体更容易在 高重复频率电光调 Q运转下实现高峰值功率的窄脉宽激光输出。在高抽运功率下,相比于复合 Nd:YVO4晶体,热 性能更加出色的复合 Nd:GdVO4 晶体更适合作为高重复频率电光调 Q运转的激光增益介质。

关键词 激光器;RTP电光Q开关;生长型复合体;高重复频率;激光二极管端面抽运

中图分类号 0436 文献标识码 A doi: 10.3788/CJL201239.0602001

150 kHz Q-Switched Adhesive-Free Bond Composite Nd:YVO₄/Nd:GdVO₄ Laser

Liu Rui Yu Yongji Chen Xinyu Wang Chao

Wu Chunting Jin Guangyong

(Key Laboratory of Solid Laser Technology and Application, School of Science, Changchun University of Science and Technology, Changchun, Jilin 130022, China)

Abstract A laser diode (LD) end-pumped RTP electro-optic (E-O) Q-switched adhesive-free bond composite crystal laser TEM₀₀ operating at repetition rate of 150 kHz is reported. Details are compared on performance of high repetition rates E-O Q-switched composite Nd: YVO₄ and Nd: GdVO₄ lasers. The experimental results reveal that under small and medium pump powers, the composite Nd: YVO₄ crystal, compared with the composite Nd: GdVO₄ crystal, has more capability to obtain higher peak power and shorter pulse width output through high repetition rates E-O Q-switched operation, for its larger stimulated emission cross-section and moderate upper-state lifetime. Compared with composite Nd: YVO₄ crystal, composite Nd: GdVO₄ crystal with excellent thermal performance under high pump power is more suitable to be the laser gain medium for high repetition rates E-O Q-switched operation. **Key words** lasers; RTP electro-optic Q-switching; adhesive-free bond composite crystal; high repetition rate; laser diode end-pump

OCIS codes 140.3538; 140.3540; 140.3580

1 引 言

激光二极管(LD)端面抽运的全固态激光器具 有较好的光束质量和较高的转换效率,伴随着 LD 制备工艺及其抽运技术的日趋完善,近年来得到了 迅速的发展。在军事国防、激光通信、激光微精细加 工等领域的许多应用中,都需要激光器以较高的重 复频率输出高峰值功率的窄脉冲,这通常是靠激光 器的调 Q 技术实现的^[1~7]。属于主动调制的电光调 Q 具有开关速度快、脉冲宽度窄和消光比高等优点, 而且容易实现精确同步控制和稳定输出,在应用中

收稿日期: 2012-02-06; 收到修改稿日期: 2012-02-29

基金项目: 吉林省科技支撑重点项目(2010PT, 20100355)资助课题。

作者简介:刘 瑞(1985—),男,硕士研究生,主要从事全固态激光器方面的研究。E-mail: istanbul916@126.com **导师简介**:金光勇(1971—),男,博士,博士生导师,主要从事全固态激光器方面的研究。

E-mail: jgyciom@163. com(通信联系人)

具有独特的优势。但是由于受到高压 Q 驱动源和 电光材料性能、制备等因素的限制,使得电光调Q 激光器的重复频率很难有所提高。近年来,随着 BBO、LGS 和 RTP 等新型电光晶体材料的出现,电 光Q开关的重复频率得到了极大的提升。2005年, Du 等^[8]利用 BBO 电光 Q 开关, 成功实现了重复频 率为 50 kHz 的端面抽运 Nd: YVO4 板条激光器运 转,输出激光脉宽 11.3 ns,光-光转换效率 41.5%, 这是目前为止有关 BBO 电光 Q 开关在激光器系统 应用中重复频率最高的报道。2010年唐昊等[9]将 LGS 晶体电光 Q 开关应用在 LD 端面抽运 Nd: YVO4激光器中。在重复频率为 30 kHz 时,实现了 最大平均功率 6.2 W,脉宽 9.1 ns,斜率效率32.7% 的激光输出。与 BBO 和 LGS 晶体相比, RTP 晶体 具有高的电阻率和更大的电光系数,可以明显降低 电光Q开关的工作电压。此外,RTP晶体的光损伤 阈值高,室温环境下无潮解而且没有压电环效 应^[10]。可以说, RTP 晶体更适合用作高重复频率 电光Q开关。2010年,Yu等[11]首次报道了端面抽 运 Nd:GdVO4 RTP 电光调 Q 激光器。在重复频率 100 kHz下,得到了最大平均功率7.9 W、最窄脉宽 20.2 ns 的激光输出,对应的光-光转换效率为 32.5%。但是未见 RTP 电光 Q 开关在重复频率高 于100 kHz 时应用的报道。

由以上可以看出,目前应用于高重复频率电光 调 Q 激光器的激光增益介质基本集中在 Nd: YVO4 和 Nd: GdVO4 两种。由于两种晶体具有大的受激 截面和高的吸收系数,可以提供实现激光器高重复 频率运转所需的高增益,而适中的上能级寿命更可 以实现窄的脉宽输出。除此之外,Nd: YVO4 和 Nd: GdVO4 晶体属于自然双折射晶体,输出是线偏振 光,这就避免了多余的热致双折射,使得退偏损耗大 大减小,特别有利于应用在电光调 Q 激光器上。本 文利用生长型复合晶体作为激光增益介质,改善了激 光器的热效应,实现了 RTP 电光调 Q 激光器150 kHz 基模运转。最大平均输出功率 10.8 W,最窄脉宽 12.7 ns,对应的光-光转换效率达到 43.2%,并且详 细比较了生长型复合 Nd:YVO₄和 Nd:GdVO₄晶体在 高重复频率 RTP 电光调 Q 激光器中的表现。

2 实验装置

近几年来,复合晶体已被证明可以有效地改善 由端面形变引起的热透镜效应,从 Chang 等^[12]的实 验结果来看,复合晶体的热透镜焦距比传统晶体长 了2倍以上。现在,随着复合晶体制造工艺的提高 产生了生长型复合晶体,基本原理是:首先正常生长 掺杂激活离子的晶体,然后设法延缓其生长并开始 非掺杂区的生长,避免了传统复合晶体表面处理带 来的缺陷^[13,14]。高重复频率 RTP 电光调 Q 激光器 示意图如图1所示。实验采用端面抽运的方式,抽运 源为光纤耦合 LD(JOLD-30-FC-14, JENOPTIK),最 大输出功率为 30 W,中心波长 808 nm。光纤芯径为 400 µm,数值孔径 NA 为 0.22。两片平-凸消色差透 镜构成了光耦合系统,耦合效率大于 97.5%,通过光 耦合系统聚焦到晶体上的抽运光斑半径约为250 µm。 增益介质采用同样规格 a 轴切割的复合 Nd: YVO4 和 Nd:GdVO₄晶体,大小均为 3 mm×3 mm×(4+7+ 4) mm,其中双端 4 mm 没有掺杂 Nd³⁺,7 mm 掺杂 Nd³⁺的浓度为 0.4% (原子数分数),晶体两个端面 均镀有 808 nm 和 1064 nm 的高透膜。另外,为了 使晶体有效冷却,将其四周用铟箔包裹后放置于紫 铜热沉中,并用半导体制冷器(TEC)对其进行冷却, 温度设定在 15 ℃±0.2 ℃。入射镜 M₁ 为平面镜, 入射端面镀 808 nm 增透膜(R<0.2%),另一端镀 808 nm 高透膜(R<5%)、1064 nm 全反膜(R> 99.9%)。输出镜 M_2 是曲率半径为200 mm的平凹镜,



图 1 实验装置示意图 Fig. 1 Schematic diagram of experimental setup

凹面对 1064 nm 的透射率为 36%, M_1 镜与 M_2 镜 构成腔长约为 90 mm 的热稳平凹腔。调 Q 方式采 用退压式, RTP 晶体作为高频电光 Q 开关放在偏振 片和输出镜之间。由于 RTP 晶体为双轴晶体, 为了 补偿温度产生的双折射效应, 常将两块晶体沿通光 方向正交放置。实验中两块相同尺寸的 x 切向 RTP 晶体沿 z 轴彼此平行, x 与 y 轴相互旋转 90° 放置。RTP 晶体尺寸为 3 mm×3 mm×10 mm, 双 端面镀有 1064 nm 增透膜(R < 1%), 与 y 轴垂直的 两个 x-z 面是 Q 开关的电极, 四分之一波电压为 570 V。电光调 Q 驱动源的上升和下降时间都少于 10 ns, 脉冲延迟时间设定在 1 μ s。

3 实验结果及分析

在同样的实验条件下分别进行复合 Nd: YVO4和 Nd: GdVO4晶体的高重复频率 RTP 电光调 Q 实验。 在高重复频率调 Q 实验中,使用 OPHIR 的 L30A-V1 功率计测量平均输出功率,光电探测器(DET10A1M, Thorlabs)和数字示波器(TDS2012B, Tektronix)分别 用来 检测脉冲信号和测量脉冲宽度, CCD 相机 (GRAS-2045M-C, Spiricon)和光束质量分析仪(M²-200 s-FW, Spiricon)分别被用作测量输出激光光强的 二维和三维分布以及它们的光束质量因子 M²。图 2 为 150 kHz 重复频率下,复合 Nd: YVO4和 Nd: GdVO4晶体的 1064 nm 激光平均输出功率和脉冲 宽度随着抽运功率的变化曲线,出于保护复合晶体 的目的,最大抽运功率为25.0 W。当抽运功率为 25.0 W 时,复合 Nd: YVO₄和 Nd: GdVO₄晶体的最 高平均输出功率分别为10.8 W和9.98 W,未见饱 和现象,对应的光-光转换效率分别为 43.2%和 39.9%,斜率效率分别为 45.5%和 43.0%。从图中 可以看出,在抽运功率低于 21.7 W 的范围内,两块 复合晶体的平均输出功率无明显差别,但是当抽运 功率高于 21.7 W 时就出现了明显的不同。当抽运 功率为 21.7 W 时,复合 Nd: YVO₄晶体得到了最窄 12.7 ns 的脉宽,最窄脉宽波形和150 kHz脉冲序列 如图 3 所示,峰-峰脉冲波动度小于 4%。图 4 为复 合 Nd: YVO₄激光器在 21.7 W 抽运功率 150 kHz 重复频率下的激光光强的二维和三维分布。从图 4 中明显可以看出激光为 TEM₀₀模输出,进一步测得 的 x和 y 方向的光束质量因子 M^2 分别为 1.116 和 1.108,如图 5 所示。



图 2 重复频率 150 kHz 时平均输出功率和脉冲宽度随 抽运功率的变化





图 3 (a)复合 Nd: YVO4 晶体单脉冲波形图; (b) 150 kHz 稳定脉冲序列

Fig. 3 (a) Oscilloscope traces of the single pulse; (b) oscilloscope traces of stable pulse series at 150 kHz

当激光器调 Q 运转时,调 Q 脉冲输出取决于超阈值度 N_i/N_t,通过分析速率方程结合 Degnan 调 Q 优化理论得到^[15]:

$$\frac{N_{\rm i}}{N_{\rm t}} \propto \tau \sigma_{\rm em} \cdot \left[1 - \exp\left(\frac{-1}{f\tau}\right)\right], \qquad (1)$$

式中 r 为上能级寿命, oem 为 1064 nm 的受激发射截

面。从(1)式可以看出在抽运时间足够长的前提下, 当激光器高重复频率运转时, N_i/N_t 不仅仅只取决 于 $\tau\sigma_{em}$ 这一乘积,还取决于式中的指数项 $-1/(f_\tau)$ 。 表 1 为 Nd:YVO₄和 Nd:GdVO₄晶体在激光器高重 复频率运转下的性能比较。





 $Q\mbox{-}switching adhesive-free bond composite Nd: <math display="inline">\rm YVO_4$ laser at 21.7 W pump power



图 5 150 kHz 复合 Nd: YVO₄电光调 Q 激光器 光束质量测量结果

Fig. 5 Measurement result of the beam quality for 150 kHz E-O Q-switching adhesive-free bond composite Nd:

YVO₄ laser

表 1 Nd: YVO4 与 Nd: GdVO4 晶体在高重复频率下的性能比较 Table 1 Comparison on the performance of Nd: YVO4 and Nd: GdVO4 crystal under high repetition rates

Gain medium	Upper level lifetime τ /μm	Stimulated emission cross-section $\sigma / (10^{-19} \text{ cm}^2)$	$\frac{N_{\rm i}}{N_{\rm t}} \propto_{\tau \sigma_{\rm em}} \cdot \left[1 - \exp\left(\frac{-1}{f\tau}\right) \right]$		
			f = 50 kHz	f = 100 kHz	f = 150 kHz
Nd : YVO_4	90	15.6	280	148	100
Nd : $GdVO_4$	95	7.6	137	72	49

以上分析可以说明,在相同抽运功率下,Nd: YVO4晶体可以提供更高的增益,即在高重复频率 下电光调Q运转时Nd:YVO4激光器可以输出更窄 的脉宽和更高的峰值功率,实验中得到了相似的结 果。由前面实验可知,当抽运功率为21.7W时,复 合Nd:YVO4晶体获得了最窄的脉冲宽度输出。所 以图6对比了复合Nd:YVO4和复合Nd:GdVO4电 光调Q激光器在21.7W抽运功率下,脉冲宽度和 峰值功率随不同重复频率的变化。重复频率范围取 20~150kHz。





Fig. 6 Pulse width and peak power versus repetition rate at 21.7 W pump power

从实验结果中看出,当电光调 Q 激光器以高重

复频率运转时,复合 Nd: YVO4 晶体的峰值功率和 脉冲宽度明显更高和更窄。重复频率为150 kHz 时,复合 Nd:YVO4 和 Nd:GdVO4 晶体分别获得 4.59 kW和 2.84 kW 的峰值功率。以上结果表明, 在中小抽运功率下,复合 Nd: YVO4 比复合 Nd: GdVO4晶体更容易获得高峰值功率和窄脉冲宽度 的激光输出。在图 2 中当抽运功率高于 21.7 W 时,复合 Nd: YVO4 晶体平均输出功率的斜率效率 明显变大,这是由晶体热透镜效应引起多模起振造 成的,而相应的热效应还会使Q开关处渡越时间增 加,导致脉宽展宽。相比复合 Nd: YVO4 晶体,复合 Nd:GdVO4晶体的平均输出功率和脉冲宽度随着抽 运功率的增加变化却很小,说明 Nd:GdVO4 晶体在 热性能方面的表现更加优秀,更适合应用在高抽运 功率的激光系统中,当抽运功率为25W时,获得最 窄 16.5 ns 的脉宽。

4 结 论

本文利用双 RTP 晶体结构电光 Q 开关,通过 LD 端面抽运生长型复合晶体实现了最高重复频率 150 kHz 的激光输出,并且详细对比了复合 Nd: YVO4和 Nd:GdVO4晶体在高重复频率电光调 Q 激 光器中的表现。在抽运功率为 25 W,重复频率为 150 kHz条件下,复合 Nd:YVO4和 Nd:GdVO4晶 体得到最大平均输出功率分别为 10.8 W 和 9.98 W,对应的斜率效率为 45.5%和 43%,最窄脉 冲宽度分别为 12.7 ns 和 16.5 ns。当抽运功率为 21.7 W时,在 150 kHz 重复频率下复合 Nd:YVO4 和 Nd:GdVO4晶体分别获得峰值功率 4.59 kW 和 2.84 kW的脉冲激光输出,进一步测得复合 Nd: YVO4晶体在 x 和 y 方向的输出光束质量 M² 因子 分别为 1.116 和 1.108,实现了 TEM₀₀模输出。实 验表明了在中小抽运功率下,具有更大发射截面和 适中上能级寿命的复合 Nd:YVO4晶体更容易实现 高峰值功率、窄脉宽激光输出。而热性能更加出色 的复合 Nd:GdVO4晶体在高抽运功率时将会取代 复合 Nd:YVO4晶体成为最适合高重复频率运转的 激光增益介质。

参考文献

1 Zhao Zhigang, Dong Yantao, Pan Sunqiang *et al.*. Investigation on LD double-end-pumped high power Q-switched YVO₄-Nd: YVO₄-YVO₄ fundamental mode solid state laser[J]. *Chinese J. Lasers*, 2010, **37**(9): 2409~2414

赵智刚, 董延涛, 潘孙强等. LD 双端面抽运 YVO4-Nd: YVO4-YVO4 复合晶体的高功率调 Q 基模激光器研究[J]. 中国激光, 2010, **37**(9): 2409~2414

2 Zhang Haikun, Xi Daoming, Wang Jing *et al.*. Control of the pulse duration in a diode-pumped doubly Q-switched Nd: GdVO₄ laser[J]. Acta Optica Sinica, 2010, **30**(3): 797~801 张海鹃, 席道明, 王 静等. 双调QNd: GdVO₄激光器的脉宽控制[J]. 光学学报, 2010, **30**(3): 797~801

3 Feng Yutong, Meng Junqing, Chen Weibiao. High pulse repetition rate, doubly Q-swithed Nd: YVO4 laser[J]. Chinese J. Lasers, 2010, 37(s1): 12~15 冯宇彤, 孟俊清,陈卫标. 高重复频率双调 Q Nd: YVO4激光器 [J]. 中国激光, 2010, 37(11): 12~15

4 Feng Yutong, Zhu Xiaolei, Tang Hao *et al.*. Characteristics of RbTiOPO₄ electro-optic *Q*-switch operation at high repetition rate [J]. *Chinese J. Lasers*, 2010, **37**(3): $617 \sim 621$

冯宇形,朱小磊,唐 吴等.磷酸钛氧铷高重复率电光调Q特性[J]. 中国激光,2010,**37**(3):617~621

- 5 Zhu Chencheng, Nie Jinsong, Tong Zhongcheng. Analysis on the mode of high repetition laser jamming[J]. Infrared and Laser Engineering, 2009, 38(6): 1060~1063 朱陈成, 聂劲松, 童忠诚. 高重频激光干扰模式的分析[J]. 红外 与激光工程, 2009. 38(6): 1060~1063
- 6 Liu Liren. Laser communications in space optical link and terminal technology[J]. *Chinese J. Lasers*, 2007, **34**(1): 3~20 刘立人.卫星激光通信 I 链路和终端技术[J]. 中国激光, 2007, **34**(1): 3~20
- 7 Zhu Xiaolei, Tang Hao, Li Xiaoli *et al.*. Recent progresses of LD pumped solid state lasers with high repetition rate electro-optic *Q*-switch[J]. *Chinese J. Lasers*, 2009, **36**(7): 1654~1659
 朱小磊,唐 吴,李小莉等. 高重复频率电光调 *Q*全固态激光器研究进展[J]. 中国激光, 2009, **36**(7): 1654~1659
- 8 K. Du, D. Li, H. Zhang *et al.*. Electro-optically *Q*-switched Nd: YVO₄ slab laser with a high repetition rate and a short pulse width[J]. Opt. Lett., 2003, **28**(2): 87~89
- 9 Tang Hao, Zhu Xiaolei, Meng Junqing *et al.*. High repetition rate short pulse width LGS electro-optic *Q*-switched Nd: YVO₄ laser[J]. Acta Optica Sinica, 2010, **30**(1): 137~141 唐 吴,朱小磊,孟俊清等.高重复频率窄脉宽LGS电光调*Q* Nd: YVO₄激光器[J]. 光学学报, 2010, **30**(1): 137~141
- 10 M. Roth, N. Angert, M. Tseitlin *et al.*. Strength problems and heat and mass transfer [C]. 2000 Proc. 3rd Int. Conf. Single Crystal Growth, 2000, 2: 416
- 11 X. Yu, C. Wang, F. Chen *et al.*. Comparison of electro-optical and acousto-optical *Q*-switched, high repetition rate Nd:GdVO₄ laser[J]. *Laser Physics*, 2011, 21(3): 442~445
- 12 Y. T. Chang, Y. P. Huang, K. W. Su *et al.*. Comparison of thermal lensing effects between single-end and double-end diffusion-bonded Nd : YVO₄ crystals for ${}^{4}F_{3/2} \rightarrow {}^{4}I_{11/2}$ and ${}^{4}F_{3/2} \rightarrow {}^{4}I_{13/2}$ transitions [J]. *Opt. Express*, 2008, **16** (25): 21155~21160
- 13 X. Li, X. Yu, J. Gao et al. Laser operation of LD end-pumped grown-together Nd: YVO₄ / YVO₄ composite crystal[J]. Laser Physics Letters, 2008, 5(6): 429~432
- 14 J. Goujon, O. Musset. Comparison between 2 different composite Nd³⁺: YVO₄ crystals in a fibre coupled diode pumped lase[J]. Advanced Solid-State Photonics, 2008. WB5
- 15 J. J. Degnan. Theory of the optimally coupled Q-switched lasers
 [J]. IEEE. J. Quantum Electron, 1989, 25(2): 214~220

栏目编辑:宋梅梅